SM16823E

特点

- ◆ 内置电源钳位模块,支持输入电源电压 5~24V
- ◆ OUT R/G/B 上电状态: 关闭
- ◆ OUT R/G/B 端口耐压 26V
- ◆ 外置 REXT 电阻调节 OUT R/G/B 输出电流值 60~350mA
- ◆ OUT R/G/B 输出电流精度: ±5%
- ◆ OUT R/G/B 输出灰度等级: 65536 级 (GAMMA 校正)
- ◆ OUT R/G/B 各 4bits 电流增益调节位
- ◆ 内置 SM-PWM 专利技术,刷新率高达 4KHz
- ◆ 同一帧显示数据同步刷新
- ◆ 采用单极性归零码数据协议
- ◆ 级联数据整形后输出,防止数据衰减
- ◆ 信号传输速率: 800Kbps
- ◆ 配合 SM17500P,应用并-串结合方案
- ◆ 内部过温保护功能
- ◆ 封装形式: SOP8

应用领域

- ◆ 室内 LED 装饰照明
- ◆ 建筑外观/情景照明
- ◆ 点光源、穿孔字
- ◆ 软灯带、线条灯

概述

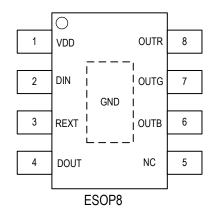
SM16823E 是单线串联的三通道 LED 恒流驱动芯片,采用单极性归零码数据协议。

SM16823E 内含电源钳位模块、信号解码模块、振荡模块、数据再生模块、输出电流设置、输出电流驱动模块等。其中数据再生模块在接受完本芯片的数据后,自动将级联输出的数据整形转发,保证数据串联传输过程中不衰减。

SM16823E 由外接的 REXT 电阻设置输出电流值 60~350mA,同时通过控制器协议数据设置 OUT R/G/B 端口电流增益,共 16 个电流增益等级。芯片输出 65536 级灰阶 (GAMMA 校正),使显示效果更趋于细腻 平滑。刷新率高达 4KHz,解决拍摄画面暗条纹问题。

SM16823E 配合 SM17500P, 可应用于并-串结合的方案上。

管脚图



内部功能框图

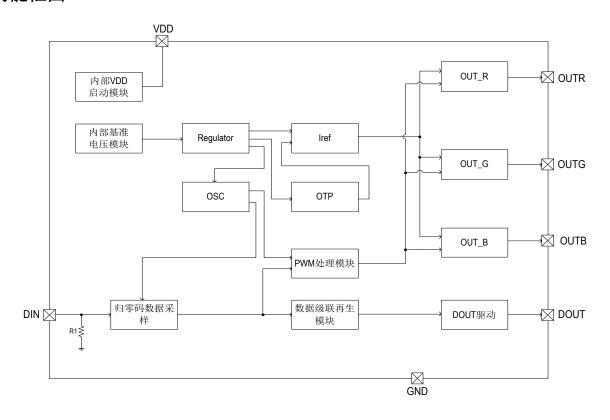


Fig. SM16823E 内部功能框图

管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚说明		
1	VDD	电源端		
2	DIN	信号输入端		
3	3 REXT 外置电阻设置 OUT R/G/B 输出电流值			
4	DOUT	级联信号输出端		
5	NC	悬空脚		
6	OUTB	恒流驱动端口		
7	OUTG	恒流驱动端口		
8	OUTR	恒流驱动端口		
衬底	GND	接地端		

订购信息

订购型号	封装形式	包装	包装方式		
1 购至 5	到农沙八	箱装	编带	卷盘尺寸	
SM16823E	ESOP8	100000 只/管	4000 只/盘	13寸	



极限参数 (注1)

若无特殊说明, T_A=25℃。

符号	参数	范围	单位
VDD	工作电压	-0.4~+5.5	V
Vı	逻辑输入电压	-0.4~VDD+0.4	V
BV _{OUT}	OUT R/G/B 端口耐压	30	V
I _{clamp}	VDD 最大钳位电流	20	mA
RθJA	PN 结到环境的热阻 (注 2)	65	°C/W
P _D	功耗 (注 3)	1.25	W
TJ	工作结温	-40~+150	$^{\circ}$
T _{STG}	储存温度	-55~+150	$^{\circ}\!$
V _{ESD}	HBM ESD	> 2	KV

注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。在极限参数范围内工作,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。

注 2: RθJA 在 T_A=25°C 自然对流下,根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。

注 3: 温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 T_{JMAX} , $R\theta JA$ 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 P_D = $(T_{JMAX}-T_A)/$ $R\theta JA$ 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。



电气工作参数 (注 4、5)

若无特殊说明, VDD=5V, T_A=25℃。

符号	参数	测试	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	内部钳位电压		外部电源 VIN=12V,VIN 与 VDD 间 的限流电阻 1KΩ		5.2	5.5	V
		外部输入	、电压≤5V	3.0	-	5.0	V
I _{DD}	静态电流	VDD=4. 5V	, Iout"OFF"	-	4.2	-	mA
V _{IH}	W > P = 22 P + F	DIN 输 <i>)</i>	高电平	0.7xVDD	-	-	V
VIL	输入信号阈值电压	DIN 输 <i>)</i>	(低电平	-	-	0.3xVDD	V
Іон	4A .1. P [] JE -1 . L \	DOUT 输出高,	对 GND 输出电流	-	-45	-	mA
l _{OL}	输出信号驱动电流	DOUT 输出低	, VDD 灌电流	-	45	-	mA
V _{REXT}	REXT 端口电压	Rext=	2.2ΚΩ	1.05	1.15	1.25	V
		V _{DS} =2V,电流 增益设置 1111	Rext=2.2KΩ	-	350	-	mA
lout_r/g/b	OUT R/G/B 输出电流		Rext=5.1KΩ	-	150	-	mA
		Hamily Line	Rext=13KΩ	-	60	-	mA
		IOUT=	350mA	-	1.1	-	V
V_{DS_S}	恒流拐点电压	IOUT=	150mA	-	0.7	-	V
		IOUT:	=60mA	-	0.5	-	V
∆ IOUT	恒流精度	IOUT = 6	0~350mA	-5		+5	%
%VS.V _{DS}		I _{OUT} =150mA,	V _{DS} =1.0~3.0V	-	1.0	-	%
%VS.VDD	OUT R/G/B 端口 输出电流变化量	I _{OUT} =150mA,	VDD=4.5~5.5V	-	1.0	-	%
%VS.T _A		I _{OUT} =150mA,T _A =-40~+85℃		-	3.0	-	%
ОТР	内部过温保护起始温度		-	-	140	-	°C
lieak	OUT R/G/B 端口漏电流	V _{DS} = 26V,	I _{OUT} "OFF"	-	-	1	uA

注 4: 电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。

注 5: 规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。

开关特性

若无特殊说明, VDD=5V, T_A= 25℃。

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{PWM}	OUT R/G/B 输出 PWM 频率	l _{OUT} =150mA,OUT R/G/B 端口串接 20Ω 电阻至 VDD	-	4	-	KHz
tрLН	信号传输延迟	DOUT端口对地负载电容 30pF,	-	73	-	ns
t _{PHL}	信亏传制延迟	DIN 至 DOUT 的信号传输延时	-	73	-	ns
tтьн	DOUT 转换时间	DOUT 端口对地负载电容 30pF	-	3.0	-	ns
tтн∟	DOUT 粒探时间	DOOI 编口N 地	-	3.0	-	ns
t _r		I _{OUT} =150mA,OUT 端口串接 20Ω 电	-	75	-	ns
t _f	OUT R/G/B 转换时间	阻至 VDD,对地负载电容 15pF	-	50	-	ns

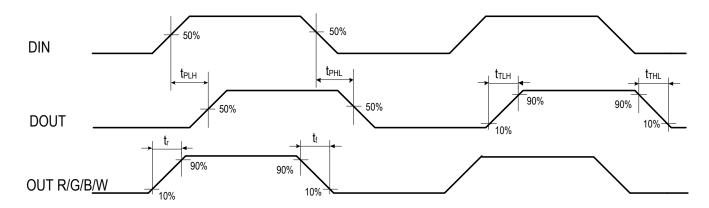


Fig. SM16823E 动态参数测试示意图



数据通信协议

1、编码描述

SM16823E 协议采用的是单极性归零码,每一个码元都必须有低电平。本协议的每个码元起始为高电平,高电平时间宽度决定"0"码或者"1"码。

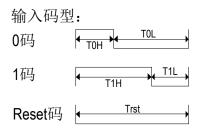


Fig. SM16823E 归零码数据通信协议图

名称	描述	最小值	典型值	最大值	容许误差	单位
ТОН	0码,高电平时间	-	0.3	-	±0.05	us
TOL	0码,低电平时间	-	0.9	-	±0.05	us
T1H	1码,高电平时间	-	0.9	-	±0.05	us
T1L	1码,低电平时间	-	0.3	-	±0.05	us
Trst	Reset码,低电平时间	200	-	-	-	us

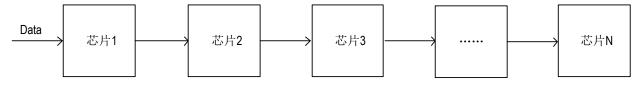
2、协议数据格式:

Trst+第一颗芯片 24bits 数据+第二颗芯片 24bits 数据+.....+第 N 颗芯片 24bits 数据+16bits 电流增益+Trst

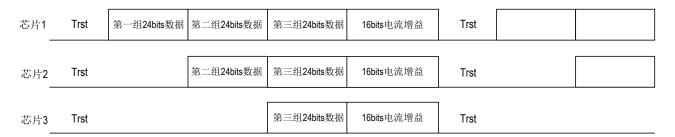
● 24bits 灰度数据结构: 高位在前, 按照 RGB 的顺序发送

R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	G7	 G0	В7	 В0
bit24.									 		 bit0

● 系统拓扑图:



● 各芯片输入数据流:





电流增益调节说明

电流增益数据共 16bits,包含保留位 4bits 和红绿蓝灯电流增益调节位各 4bits,分别对应 4bits(S3~S0),系统发送顺序是先红灯的 4bits,再发绿灯 4bits,再发蓝灯 4bits,最后发保留位 4bits。先发高位 S3,最后发低位 S0。

电流增益数据发送格式							
红灯 (R)	红灯 (R)						
S3, S2, S1, S0 S3, S2, S1, S0 S3, S2, S1, S0 S3, S2, S1, S0							

注:保留位数据不影响电流增益调节。

电流增益范围为 1~16级, 电流增益等级与电流增益数据位对应关系如下表所示。

电流增益	S3	S2	S1	S0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0
4	0	0	1	1
5	0	1	0	0
6	0	1	0	1
7	0	1	1	0
8	0	1	1	1
9	1	0	0	0
10	1	0	0	1
11	1	0	1	0
12	1	0	1	1
13	1	1	0	0
14	1	1	0	1
15	1	1	1	0
16	1	1	1	1

恒流特性

达到恒流拐点后,SM16823E输出电流不受OUT端口电压VDS影响。

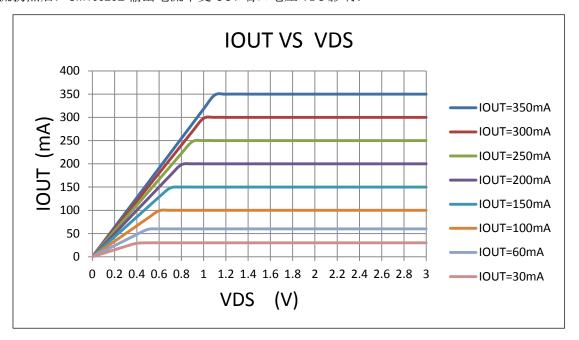


Fig. SM16823E lour与 OUT 端口电压 Vps 的关系图

输出电流设置

SM16823E 的输出电流由外接 RexT电阻和电流增益等级 G 设定。电流增益为第 16 级时,输出电流 lour 与 RexT电阻值如下公式所示:

$$I_{OUT}$$
 (mA) = $\frac{1100}{R_{est}} \times 720$

电流增益为 1~15 级时,输出电流 lour与 Rext 电阻值如下公式所示:

$$I_{OUT}$$
 (mA) = $\frac{1100}{R_{est}} \times (208 + (G \times 32))$

公式中:

REXT 是指外接至 REXT 端的电阻值;

G是指电流增益等级。

若 G=1, $R_{EXT}=2200\Omega$,通过公式计算可得输出电流值 120mA;

输出电流 lout与 Rext 电阻关系如下图所示:

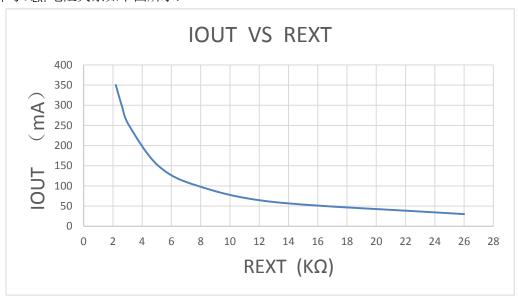


Fig. SM16823E I_{OUT}与 R_{EXT}电阻关系图(VDD=5.0V)

过温调节功能

当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。SM16823E 集成了温度补偿功能,当芯片内部温度达到 140°过温点时,芯片将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。

典型应用

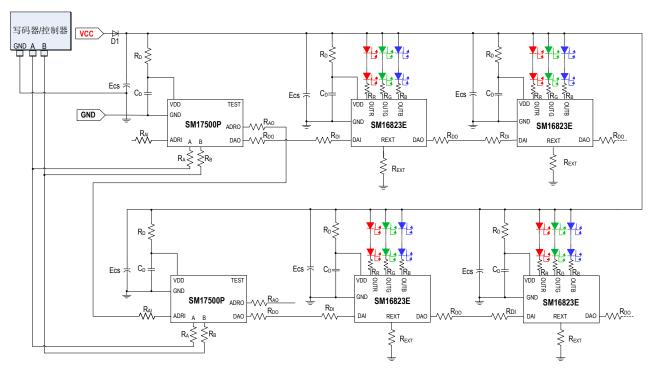


Fig. SM16823E 典型应用方案图

SM16823E 典型应用电路参数包含外部输入电压 VCC,EC_S是电源滤波电容,系统防反接二极管 D1,芯片限流电阻 R_D ,VDD 稳压电容 C_D 和 R/G/B LED 分压电阻 R_R 、 R_G 、 R_B ,DIN 信号输入端口串接电阻 R_D ,DOUT 信号输出端口串接电阻 R_D 。

(1)VCC 为外部输入电压, R_D 为限流电阻,用于限定芯片稳压功能开启时内部稳压模块的工作电流。芯片工作电压 $VDD = VCC - I_{DD} \times R_D$,其中 I_{DD} 是芯片静态电流, R_D 阻值必须保证 VDD > 3V。 R_D 电阻越大,系统功耗越低,但系统抗干扰能力弱; R_D 电阻越小,系统功耗越大,工作温度较高,设计时需根据系统应用环境合理选择电阻 R_D 。不同的输入电源电压 VCC,限流电阻 R_D 的设计参考值如下表:

VCC(V)	5	6	9	12	15	18	24
$R_D(\Omega)$	33	100	300	510	1K	1.5K	2K

- (2) D1 为系统防反接二极管,用于防止系统电源反接时击穿电解电容。系统方案选择灯珠反向可导通时,也需要通过 D1 二极管防止电源反接时击穿芯片。D1 选择可根据实际应用的负载情况进行选择。
 - (3) 电源滤波电容 ECs用于降低电源波动,选用电解电容,可根据实际应用的负载情况选择 4.7~100uF。
 - (4) Cn为芯片稳压滤波电容,用于稳定芯片的 VDD 电压,保证芯片正常工作,Cn建议取值为 100nF 电容;
- (5) R_{DI}为 DIN 信号输入端口保护电阻,防止带电热拔插、电源正负极与信号线反接等情况造成信号输入端口损坏;
- (6) R_{DO} 为 DOUT 信号输出端口保护电阻,防止带电热拔插、电源正负极与信号线反接等情况造成信号输出端口损坏;
- (7) R_R、R_G、R_B分别为 OUT R/G/B 端口的分压电阻,用于减小 OUT R/G/B 端口电压,降低芯片功耗。其计算 公式为R_R/R_G R_B(Ω)= $\frac{VCC \cdot V_{DS} \cdot N \times V_{LED}}{I_{OUT}}$,其中 VCC 是外部输入电压,V_{LED} 是 LED 灯导通电压降, I_{OUT} 是端口输出电流,V_{DS}



是芯片 OUT R/G/B 端口电压,实际应用中应保证 V_{DS} 取值高于恒流拐点电压,同时使芯片产生较少的功率损耗。具体以实际应用为准,不同颜色灯珠压降 V_{LED} 参考值如下: 红灯压降约为 2.0~2.2V,绿、蓝压降约为 3.0~3.2V,具体请以灯珠实际规格为准。

在典型的应用中,根据不同的输入电压,不同的灯珠数量,对应的各参数建议取值如下表:

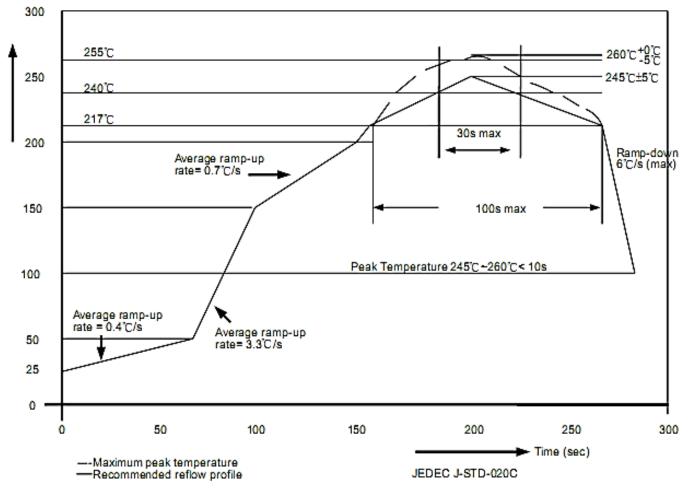
VCC(V)	OUT 端口串接 LED 数(颗)	$R_D(\Omega)$	C _D (nF)	R _A (Ω)	R _B (Ω)	R _{DI} (Ω)	R _{DO} (Ω)
5	1	33	100	10K	10K	200	200
12	3	510	100	10K	10K	510	510
24	6	2K	100	10K	10K	510	510



封装焊接制程

明微电子所生产的半导体产品遵循欧洲 RoHs 标准,封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。

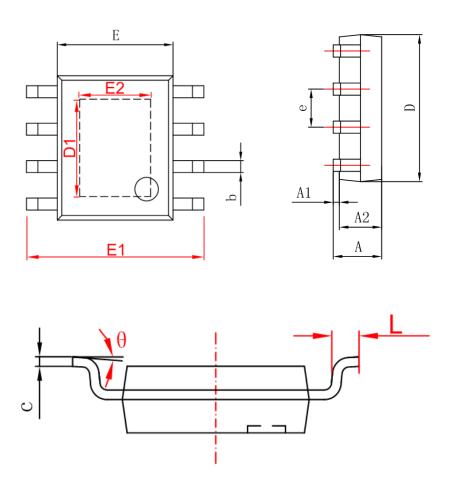
Temperature (℃)



封装厚度	体积 mm³< 350	体积 mm³: 350~2000	体积 mm³≥ 2000
<1.6mm	260+0℃	260+0℃	260+0℃
1.6mm~2.5mm	260+0℃	250+0℃	245+0℃
≥2.5mm	250+0°C	245+0°C	245+0°C

封装形式

ESOP8



Symbol	Min(mm)	Max(mm)
A	1.25	1.95
A1	-	0.1
A2	1.25	1.75
b	0.25	0.7
С	0.1	0.35
D	4.6	5.3
D1	3.12(REF)	
E	3.7	4.2
E1	5.7	6.4
E2	2.34(REF)	
е	1.270(BSC)	
L	0.2	1.5
Θ	0°	10°

使用权声明

明微电子对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善和终止的权利。针对上述的权利,客户在进行产品购买前,建议与明微电子业务代表联系以取得最新的产品信息。

明微电子的产品,除非经过明微合法授权,否则不应使用于医疗或军事行为上,若使用者因此导致任何身体 伤害或生命威胁甚至死亡,明微电子将不负任何损害赔偿责任。

此份文件上所有的文字内容、图片、及商标为明微电子所属之智慧财产。未经明微合法授权,任何个人和组织不得擅自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表等损害本企业合法权益。对于相关侵权行为,本企业将立即全面启动法律程序,追究法律责任。